
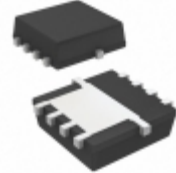







	<h2 style="color: red;">SI7720DN-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7720DN-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7720DN-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27594 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7720DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	27594 pcs Stock
Serie	SkyFET®, TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.5 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1790pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



SI7720DN-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7720DN-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7720DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7720DN-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7726DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>	 <p><b>SI7726DN-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>	 <p><b>SI7720DN-T1-E3</b> VISHAY SI7720DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7720DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8</p>
 <p><b>SI7726DN</b> VB SI7726DN VB</p>	 <p><b>SI7726DN-T1-E3</b> VISHAY SI7726DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7720DN</b> VISHAY SI7720DN VISHAY</p>	 <p><b>SI7716DN-T1-GE3</b> Vishay Precision Group SI7716DN-T1-GE3 VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI7686DP	 SI7686DP-T1	 SI7686DP-T1-E3	 SI7686DP-T1-E3	 SI7686DP-T1-GE3
 SI7686DP-T1-GE3	 SI7703DN	 SI7703EDN	 SI7703EDN-T1	 SI7703EDN-T1-E3
 SI7703EDN-T1-E3	 SI7703EDN-T1-GE3	 SI7703EDN-T1-GE3	 SI7703EDN-TI-E3	 SI7705DN
 SI7705DN-T1	 SI7705DN-T1-E3	 SI7716ADN	 SI7716ADN-T1-E3	 SI7716ADN-T1-GE3
 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716ADN-TI-GE3	 SI7716DN-T1-GE3	 SI7720DN-T1-E3	 SI7720DN-T1-GE3
 SI7726DN	 SI7726DN-T1-E3	 SI7726DN-T1-GE3	 SI7726DN-T1-GE3	 SI7732DP-T1-GE3
 SI7738DP	 SI7738DP-T1-3	 SI7738DP-T1-E3	 SI7738DP-T1-E3	 SI7738DP-T1-GE3
 SI7738DP-T1-GE3	 SI7742DP-T1-E3	 SI7742DP-T1-GE3	 SI7742DP-T1-GE3	 SI7748DP-T1-GE3
 SI7748DP-T1-GE3	 SI7758DP	 SI7758DP-T1-GE3	 SI7758DP-T1-GE3	 SI7772DP-T1-GE3
 SI7772DP-T1-GE3	 SI7774DP-T1-GE3	 SI7774DP-T1-GE3	 SI7784DP-T1-GE3	 SI7784DP-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited